

บทที่ 2

ทฤษฎี

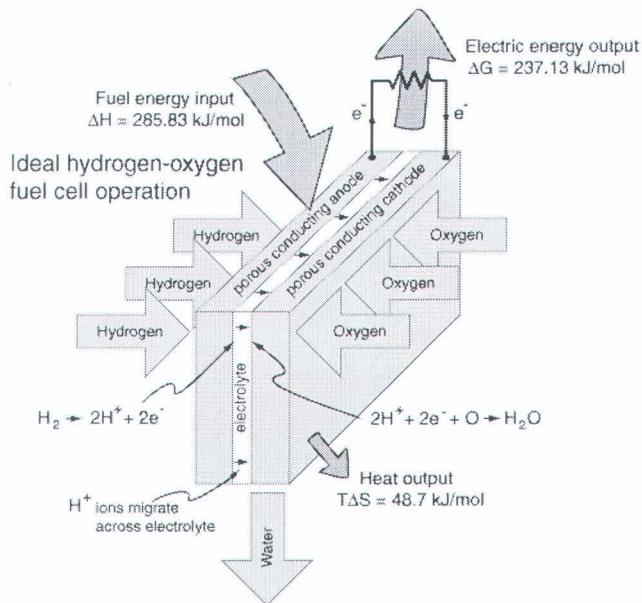
2.1 เชลล์เชื่อเพลิง (Fuel Cell) [1]

เชลล์เชื่อเพลิง คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ซึ่งลักษณะการทำงานคล้ายกับแบตเตอรี่ แต่มีข้อดีกว่าแบตเตอรี่ตรงที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องทราบเท่าที่มีการป้อนเชื้อเพลิงในรูปของเหลวหรือก๊าซเข้าไปอย่างสม่ำเสมอ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลที่ได้จากปฏิกิริยาของเชลล์เชื่อเพลิงคือ น้ำ และความร้อน

เชลล์เชื่อเพลิงประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าที่มีความพรุน คือ แອโนดและแคโทด สัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งอาจเป็นของแข็งหรือของเหลว โดยการทำงานของเชลล์เชื่อเพลิงนี้เริ่มจากขั้วแອโนดได้รับเชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซไฮdroเจน จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ซึ่งโมเลกุลก๊าซไฮdroเจนแตกตัวให้อิเล็กตรอน (e^-) กับ โปรตอน (H^+) ดังสมการที่ 1 โดยโปรดอนสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปยังขั้วแคโทดได้ เนื่องจากสารอิเล็กโทรไลท์มีคุณสมบัติเป็นตัวนำโปรดอน อิเล็กตรอนอิสระจะเคลื่อนที่ผ่านวงจรภายนอกเพื่อไปยังขั้วแคโทด เมื่อขั้วแคโทดได้รับก๊าซออกซิเจนรวมตัวกับอิเล็กตรอนและโปรดอนแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเรดักชัน (reduction) ที่ขั้วแคโทดดังสมการที่ 2 ซึ่งผลจากปฏิกิริยาจะได้โมเลกุลของน้ำรวมทั้งเกิดความร้อนดังสมการที่ 3

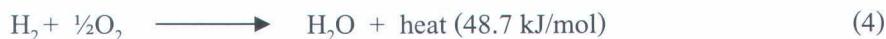


การทำงานของเชลล์เชื่อเพลิงสามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ ที่เรียกว่า Thermodynamics Potentials โดยอาศัยความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์สามารถอธิบายการทำงานของเชลล์เชื่อเพลิงได้ดังรูปที่ 2.1



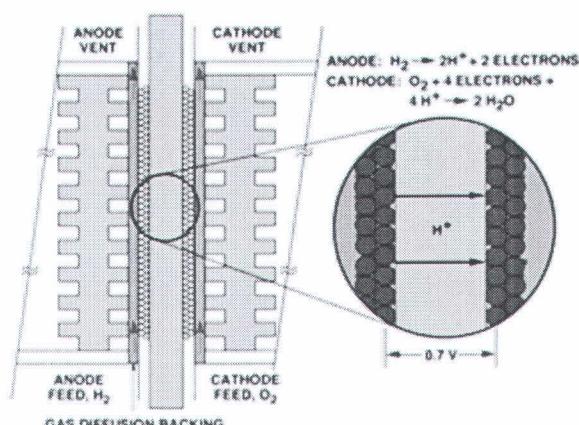
รูปที่ 2.1 แสดงการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงในเชิงอุณหพลศาสตร์ [45]

ปฏิกริยาเคมีระหว่างกําชไออกซิเจนและกําชออกซิเจนเป็นปฏิกริยาที่ปล่อยพลังงานออกมากดังสมการที่ 4



2.2 เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนประตอน

เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนประตอน มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ คือหน่วยแผ่นเยื่อและข้าไฟฟ้า (Membrane Electrode Assembly: MEA) ดังแสดงดังรูปที่ 2.2 MEA จะทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าจากปฏิกริยาไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างเชื้อเพลิงกําชไออกซิเจน (H_2) และกําชออกซิเจน (O_2)



รูปที่ 2.2 แสดงภาพตัดขวางของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดพอลิเมอร์อิเล็กโทรโอลด์ [45]

เซลล์เชือเพลิงชนิดนี้ประกอบด้วยแผ่นเยื่อพอลิเมอร์ (Membrane) ซึ่งทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนไอออนไฮโดรเจนหรือโปรดอน โดยที่แผ่นเยื่อดังกล่าวจะถูกประกอบด้วยข้าไฟฟ้าที่มีรูพรุน และมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นแพลตตินัมกระจายอย่างสม่ำเสมอ น้ำที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้จะถูกดึงออกจากเซลล์พร้อมกับก๊าซที่เหลือจากการเกิดปฏิกิริยาทางขั้วแค็ปโตด ส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกดึงออกโดยระบบหล่อเย็น (cooling system) การทำงานของเซลล์เชือเพลิงชนิดนี้ต้องอาศัยความชื้นเป็นตัวกลางในการพาไฮโดรเจนไอออนให้เคลื่อนที่ผ่านแผ่นเยื่อจากขั้วแอนโอดไปขั้วแค็ปโตด เนื่องจากแผ่นเยื่อมีคุณสมบัติในการนำไอออนได้ดีเมื่อมีความชื้น ดังนั้นก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาต้องเป็นก๊าซที่มีความชื้น (Humidified gases)

2.2.1 แผ่นเยื่อ(Membrane) [1]

เซลล์เชือเพลิงชนิดนี้ใช้แผ่นเยื่อพอลิเมอร์ซึ่งอยู่ในสถานะของแข็งเป็นอิเล็กโทรไลต์ และเนื่องจากอิเล็กโทรไลต์นี้ค่อนข้างบางจึงถูกเรียกว่าเป็นแผ่นเยื่อ ซึ่งแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์ของเซลล์เชือเพลิงชนิดนี้ จะมีลักษณะเป็นแผ่นเยื่อพอลิเมอร์เหมือนพลาสติก โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

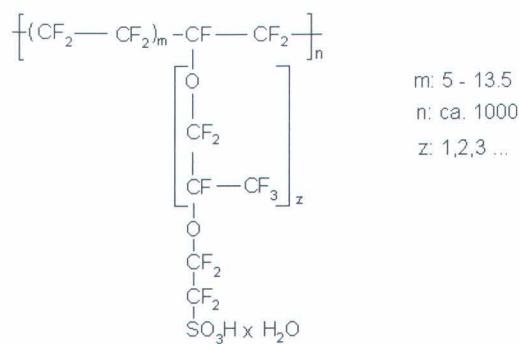
- (1) มีค่าการนำไอออนสูงแต่มีค่าการนำอิเล็กตรอนต่ำ
- (2) มีค่าการแพร่ของก๊าซและน้ำต่ำ
- (3) มีขนาดที่แน่นอน
- (4) มีค่าความแข็งแรงเชิงกลสูง
- (5) มีความต้านทานต่อการสูญเสียน้ำ (dehydration)
- (6) มีความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชัน รีดักชันและกระบวนการแยกสลาย

ด้วยน้ำ(hydrolysis)

แผ่นเยื่อพอลิเมอร์มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนเป็นโมเลกุลของ perfluorosulfonic acid (PTSA) ประกอบด้วยสารส่วนคือ polytetrafluoroethylene (PTFE) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสายโซ่ของ $-O-CF_2-CF-O-CF_2-CF_2$ และกลุ่มของไอออนของ sulfonic acid ข้อดีของการใช้แผ่นเยื่อ PTSA ในเซลล์เชือเพลิงชนิดพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ คือ มีความแข็งแรงและเสถียรในสภาพแวดล้อมที่เกิดออกซิเดชันและรีดักชัน นอกจากนี้ยังมีสมบัติการนำโปรดอนที่ดีเมื่อมีอิฐในระดับความชื้นเหมาะสม เนื่องจากแผ่นเยื่อมีคุณสมบัติความเป็นกรด จึงจำเป็นต้องมีสัดส่วนโมเลกุลของน้ำต่อไฮโดรเจนไอออน ที่ทำให้เกิดการนำไฮดอนไดด์ที่สุดคือประมาณ 3:1 ดังนั้นค่าการนำไฮดอนของแผ่นเยื่อพอลิเมอร์จึงขึ้นอยู่กับค่าความดันน้ำที่ดำเนินการ ภายนอกเซลล์ อุณหภูมิเซลล์ และขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของความชื้นด้วย ปริมาณความต้องการความชื้นขึ้นอยู่กับ

ความหนาของแผ่นเยื่อ โดยแผ่นเยื่อบางจะมีความต้องการความชื้นน้อยกว่าแผ่นเยื่อที่หนากว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์เชือเพลิงเมื่อใช้แผ่นเยื่อบางจะต้องการปริมาณน้ำอยู่มาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าความแตกต่างของความเข้มข้นของน้ำระหว่างขั้วคาโทดและอะโนดสูงมาก ดังนั้นจะเกิดการแพร่ของน้ำภายในเซลล์จากขั้วคาโทดไปยังอะโนด ทำให้ที่ขั้วอะโนดเกิดความชื้นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ทำความชื้นจากภายนอก เรียกกระบวนการนี้ว่า self humidifying ซึ่งจะเกิดเฉพาะแผ่นเยื่อบางเท่านั้น สำหรับแผ่นเยื่อที่หนาจำเป็นต้องอาศัยความชื้นที่เกิดจากเครื่องทำความชื้นภายนอก (Watanabe *et al.*, 1996)

วัสดุที่นำมาใช้ทำเยื่อแผ่นโดยทั่วไปใน PEMFC คือ Nafion® รูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้างของ Nafion® ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอนวนไฟฟ้า และสามารถนำไอออนไสโตรเจนได้ดี



รูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้างของ Nafion® [1]

2.2.2 ไบโพลาร์ เพลต (Bipolar Plates) [1]

ในเซลล์เชือเพลิงแบบเซลล์เดียวจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไบโพลาร์เพลต จะเป็นเพียงเพลตสองแผ่นที่อยู่คนละข้างกับหน่วยแผ่นเยื่อและขั้วไฟฟ้าหรือ MEA เท่านั้น แต่ในเซลล์ที่ต่ออนุกรมกันเป็นหลายเซลล์แล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมแອโนดของเซลล์หนึ่งไปสู่แคโทดของอีกเซลล์หนึ่ง ดังนั้นไบโพลาร์เพลตจึงมีบทบาทสำคัญสำหรับการต่อเซลล์เป็นอนุกรมหรือสแตกเซลล์คุณสมบัติของไบโพลาร์เพลต ความมีดังนี้

- (1) ไบโพลาร์เพลตเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบอนุกรม ดังนั้นจึงควรเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดี
- (2) ไบโพลาร์เพลตแยกแก๊สสองชนิดไว้คนละข้าง ดังนั้นจึงควรมีค่าซึมผ่านของแก๊สต่ำ

- (3) ไบโพลาร์เพลตเป็นโครงสร้างของสแตกเซลล์ ดังนั้นจึงควรมีความแข็งแรง
ทนทานกับอุณหภูมิที่ต่างกัน
- (4) ไบโพลาร์เพลตนำความร้อนจากปฏิกิริยาของเซลล์และระบบความร้อนออก
จากเซลล์ ดังนั้นจึงควรมีความสามารถร้อนได้ดี
- (5) ไบโพลาร์เพลตมีร่องทางเดินของไฟล์ ดังนั้นจึงควรขึ้นรูปหรือทำให้เป็นร่อง
ได้

ตาราง 2.1 Bipolar Plates Design Criteria

<i>Property</i>	<i>Requirements</i>	<i>Comment</i>
Electrical conductivity	$>100 \text{ S cm}^{-1}$	Bulk conductivity
Corrosion rate	$<16 \text{ A cm}^{-2}$	
Hydrogen permeability	$<2 \times 10^{-6} \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$	@80°C, 3 atm
Compressive strength	$>2 \text{ MPa}$	
Thermal conductivity	$>20 \text{ W/mK}$	Strong function of stack design – some designs may require higher thermal conductivity
Tolerance	$<0.05 \text{ mm}$	
Cost	$<\$10/\text{kW}$	
Weight	$<1\text{kg/kW}$	

นอกจากนี้ ไบโพลาร์เพลตควรต้านทานการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมของเซลล์ แต่ไม่ใช่วัสดุที่ยากหรือวัสดุที่มีราคาสูงเกินไป เพื่อทำให้ต้นทุนของเซลล์ต่ำและง่ายต่อการผลิตจำนวนมากหรือในระดับอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดที่ได้กล่าวข้างต้นอาจจะขัดแย้งระหว่างกัน ถึงแม้วัสดุที่นำมาทำไบโพลาร์เพลตจะไม่ได้มีคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่งคือสุด แต่เป็นค่าที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติใดมากที่สุด เช่น ควรได้ราคาต่อกิโลวัตต์ของกำลังไฟฟ้ามากในระดับที่กำหนดไว้ เป็นต้น ดังตาราง 2.1 ซึ่งเป็นเกณฑ์การออกแบบไบโพลาร์เพลต

2.3 คุณสมบัติของไทเทเนียม ในโครงสร้าง และไทเทเนียมในไตรด์

2.3.1 ไทเทเนียม (Titanium) [10]

ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติของ ไทเทเนียม

คุณสมบัติ	ชื่อและปริมาณ
Symbol:	Ti
Atomic Number:	22
Atomic Weight:	47.88
Element Classification:	Transition Metal
Discovered By:	William Gregor
Discovery Date:	1791 (England)
Name Origin:	Greek: titanos (Titans)
Density (g/cc):	4.54
Melting Point (K):	1933
Boiling Point (K):	3560
Appearance:	Shiny, dark-gray metal
Atomic Radius (pm):	147
Atomic Volume (cc/mol):	10.6
Covalent Radius (pm):	132
Ionic Radius:	68 (+4e) 94 (+2e)
Specific Heat (@20°C J/g mol):	0.523
Fusion Heat (kJ/mol):	18.8
Evaporation Heat (kJ/mol):	422.6
Debye Temperature (K):	380.00
Pauling Negativity Number:	1.54
First Ionizing Energy (kJ/mol):	657.8
Oxidation States:	4, 3
Electronic Configuration:	[Ar] $3d^2 4s^2$
Lattice Structure:	1.588

2.3.2 ไนโตรเจน (Nitrogen) [11]

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติของไนโตรเจน

คุณสมบัติ	ข้อมูลและปริมาณ
Symbol:	N
Atomic Number:	7
Atomic Weight:	14.00674
Element Classification:	Non-Metal
Discovered By:	Daniel Rutherford
Discovery Date:	1772 (Scotland)
Name Origin:	Greek: nitron and genes, (soda forming)
Density (g/cc):	0.808 (@ -195.8°C)
Melting Point (K):	63.29
Boiling Point (K):	77.4
Appearance:	Colorless, odorless, tasteless, and generally inert gas
Atomic Radius (pm):	92
Atomic Volume (cc/mol):	17.3
Covalent Radius (pm):	75
Ionic Radius:	13 (+5e) 171 (-3e)
Specific Heat (@20°C J/g mol):	1.042 (N-N)
Pauling Negativity Number:	3.04
First Ionizing Energy (kJ/mol):	1401.5
Oxidation States:	5, 4, 3, 2, -3
Electronic Configuration:	[He] 2s ² 2p ³
Lattice Structure:	Hexagonal (HEX)
Lattice Constant (Å):	4.039
Lattice C/A Ratio:	1.651



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่..... ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖
เลขที่รับเรียน..... 248006
เลขเรียกหนังสือ.....

2.3.3 ไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) [12]

ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติของ ไทเทเนียมไนไตรด์

คุณสมบัติ	ปริมาณและโครงสร้าง
Molecular formula	TiN
Molar mass	61.874 g/mol
Appearance	Coating of golden color
Density	5.40 g/cm ³
Melting point	2930 °C
Crystal structure	Cubic, cF8
Coordination geometry	Octahedral

ไทเทเนียมไนไตรด์ (Titanium nitride: TiN) เป็นเซรามิกที่มีความแข็งมาก นิยมผลิตเป็นฟิล์มบางเพื่อนำไปเคลือบผิวสัมผัสที่มีส่วนประกอบประเทต ไทเทเนียมอัลลอย สารต้านการข้าม และอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความแข็งให้กับพื้นผิวที่ได้รับการเคลือบ หรือใช้เคลือบพื้นผิวที่เน้นประดับให้สวยงามในทางการแพทย์ เพราะสีของ ไทเทเนียมไนไตรด์มีสีทอง ความหนาของฟิล์มบางน้อยกว่า 5 μm

ไทเทเนียมไนไตรด์มีค่าออกซิไดซ์ที่ 800 °C ในบรรยากาศปกติ และค่อนข้างทนต่อปฏิกิริยาเคมีที่อุณหภูมิปกติ แต่ไม่สามารถรับได้กับกรดเข้มข้นที่อุณหภูมิสูง สะท้อนรังสีอินฟราเรด ได้ดี ผลจากการสะท้อนจะให้สเปกตรัมที่เป็นสีทอง เช่นเดียวกับสเปกตรัมของชาตุทองคำ มีค่า coefficient of friction ตั้งแต่ 0.4 ถึง 0.9 มักจะเกาะตัวกันเป็นคริสตัลแบบเดียวกับ NaCl ในอัตราส่วน 1:1 อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบของชาตุ TiN_x มักจะมีค่า x ตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.2 ซึ่งขึ้นอยู่ในค่าที่เสถียร

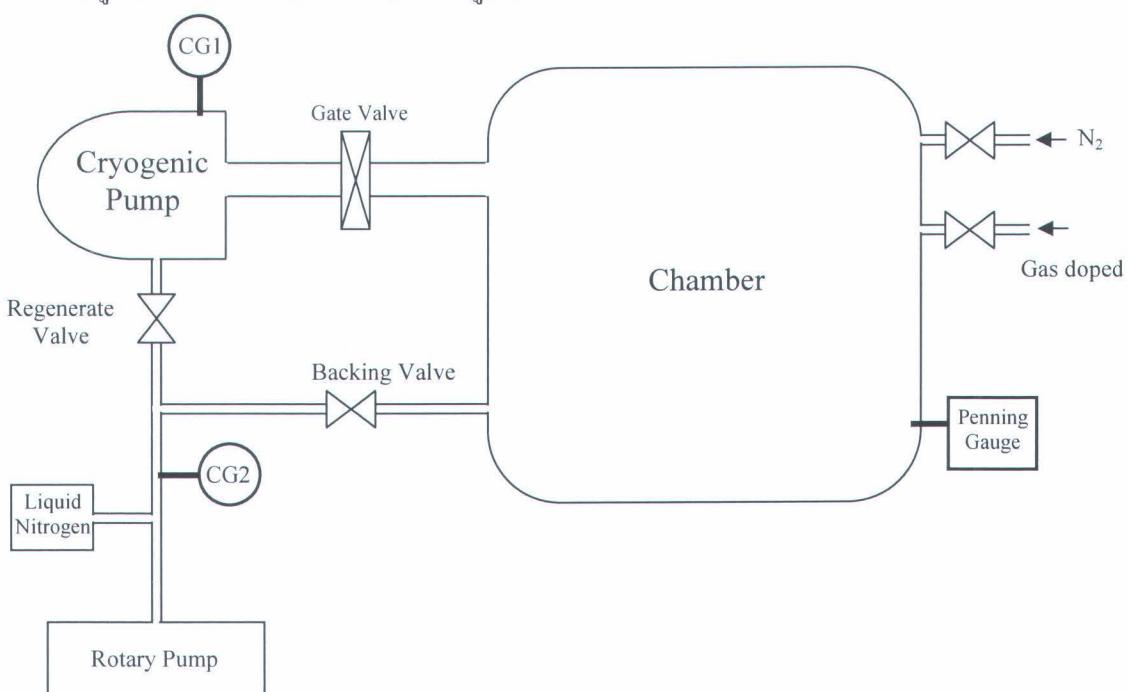
การประยุกต์ใช้ฟิล์มบาง ไทเทเนียมไนไตรด์คือการนำไปเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องจักรกล เช่น คอกสว่าน ใบมีดของเครื่องตัดหรือเครื่องบด ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้ถึงสามเท่าหรืออาจมากกว่านั้น และการที่เป็นฟิล์มที่มีสีทอง บางคราวจึงใช้เคลือบพื้นผิวเครื่องประดับต่างๆ ได้ ไทเทเนียมไนไตรด์ นอกจากนี้ยังใช้ในอุปกรณ์การแพทย์ได้ เพราะได้รับการรับรองจาก FDA หรือองค์กรอาหารและยา ว่าเป็นสารประกอบที่ไม่เป็นพิษ อุปกรณ์การแพทย์ได้แก่ มีดผ่าตัดให้คงความคมไว้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ไทเทเนียมไนไตรด์ยังใช้ในการเคลือบพื้นผิวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กได้ เช่นใช้เป็นกำแพงตัวนำกันระหว่างแอดกที่ฟักฟอกโลหะ ฟิล์มจะเป็นสิ่งที่ป้องกันการกระจายตัวของโลหะ

ไปสู่ซิลิกอน เพราะมีค่านำไฟฟ้าเพียงพอ ($30\text{--}70 \mu\Omega\cdot\text{cm}$) จะใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบางครั้งยังใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในไบโอดิอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

2.4 หลักการของเครื่องฟิลเตอร์แคโทดิกอาร์ค (FCVA) [1, 13 – 14]

แหล่งกำเนิดพลาasmaแบบฟิลเตอร์แคโทดิกอาร์ค (Filtered Cathodic Vacuum Arc or FCVA) ชนิดไม่ใช้ทริกเกอร์อิเล็กโทรด การกำเนิดพลาasmaจะเกิดได้ดีในระบบสุญญากาศ ดังนั้นระบบจึงประกอบด้วยระบบสุญญากาศ ภายในอุโมงค์ (chamber) เป็นระบบปิดที่มีช่องทางสำหรับดูดอากาศออกโดยปั๊มสองชนิดดังรูป 2.4

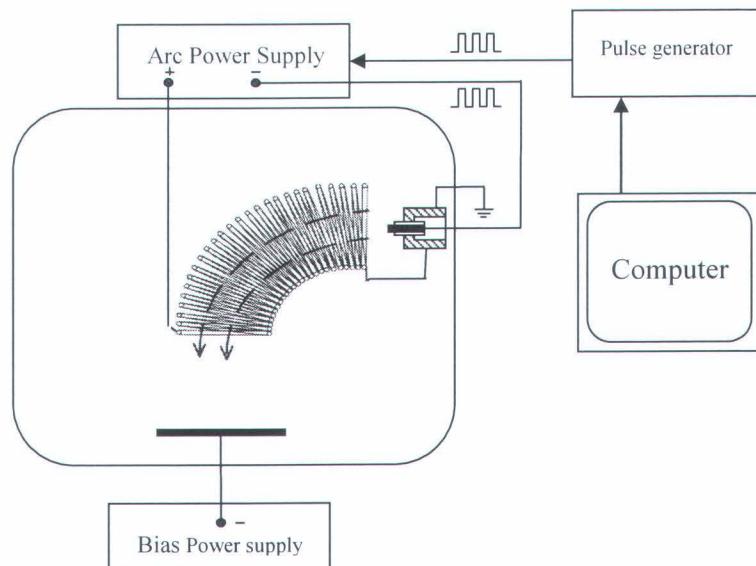


รูป 2.4 จำลองระบบสุญญากาศ

การทำงานของระบบสุญญากาศประกอบด้วยปั๊มโรตารี (rotary pump) และปั๊มไครโอล Jen นิก (cryogenic pump) ซึ่งสามารถดูดอากาศออกได้ถึงประมาณ 10^{-7} ทอร์ หลักการทำงานของปั๊มไครโอล Jen นิกคือการทำให้ก๊าซภายในหัวปั๊มควบแน่นเป็นของเหลวซึ่งมีความเย็นจัด足以ทำให้ก๊าซภายในอุโมงค์ทัดลงถูกดูดมาไว้ในหัวปั๊ม และลดความดันภายในอุโมงค์ในที่สุด

หากต้องการใช้ก๊าซร่วมในการเคลือบผิว ก็สามารถปล่อยก๊าซเข้าได้ที่ช่องก๊าซร่วม (gas doped) และมีช่องสำหรับก๊าซไนโตรเจน (N_2) เข้าเพื่อปรับความดันภายในอุโมงค์ให้เท่ากับภายนอกเมื่อต้องการจะเปิดฝาอุโมงค์ทัดลง

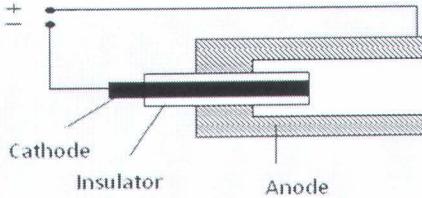
รูปที่ 2.5 เป็นภาพจำลองระบบไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบแคลโทดิกาวาร์ค ไอออนพลาสมากำเนิดมาจากสสารที่เป็นส่วนของแคลโทด ซึ่งเป็นแท่งของเบ็งของชาตุชนิดที่ต้องการนำมาทำเป็นฟิล์มบาง การทดลองนี้ใช้แท่งโลหะไทเทเนียม



รูปที่ 2.5 ไดอะแกรมแสดงการจัดการทดลองเคลือบฟิล์มไทเทเนียมในไตรค์ด้วยแคลโทดิกาวาร์ค

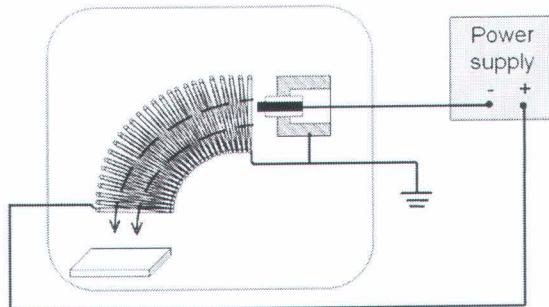
การทำงานจะเริ่มโดยการติดตั้งเครื่องมือในอุโมงค์ตามตำแหน่งดังรูป 2.5 และเริ่มต้นจากการสั่งการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถกำหนดอัตราส่วนและความถี่ในการจ่ายสัญญาณพลังส์ระหว่างแหล่งกำเนิดทั้งสองได้ คอมพิวเตอร์จะสั่งการไปยังกล่องควบคุมซึ่งจะควบคุมการทำงานของแหล่งจ่ายไฟให้สัมพันธ์กับระบบพัลส์ ซึ่งประกอบด้วยพัลส์ ฟอร์มมิ่ง เน็ตเวิร์ค จำนวน 10 ชั้น ความด้านทานภายในเท่ากับ 0.7 โอม สามารถให้กระแสอาร์คเกิน 200 แอมป์ ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับพัลส์ ฟอร์มมิ่ง เน็ตเวิร์ค ซึ่งในการทดลองนี้ จ่ายแรงดันคงที่ขนาด 450 โวลท์ ได้กระแสอาร์คประมาณ 500 แอมป์ มีความกว้างของพลาสม่าส์ประมาณ 160 ไมโครวินาที และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังแหล่งกำเนิดพลาสม่า (plasma source) ภายในอุโมงค์

ลักษณะพิเศษของเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบแคลโทดิกาวาร์คแบบมีฟิลเตอร์คือเป็นการสร้างพลาสมากองเบ็งหรือแคลโทด โดยมีหลักการทำงานโดยให้ข้าวแอนดอนดและแคลโทด (แท่งของเบ็งที่ต้องการพลาสมานิคนี้) วางใกล้กันแต่คั่นด้วยฉนวนไฟฟ้าดังรูปที่ 2.6 ใน การทดลองนี้ใช้เชรามิกเป็นฉนวน เมื่อมีการให้ความต่างศักย์ระหว่างข้าวไฟฟ้าที่มากพอจะทำให้เกิดการอาร์คระหว่างข้าวไฟฟ้าทั้งสอง ซึ่งจะเป็นตัวการให้สารที่ผิวน้ำของแคลโทดหลุดออกเป็นไอออนบวกและอิเล็กตรอนเป็นลำพลาสม่า



รูปที่ 2.6 ไดอะแกรมแสดงภาคตัดขวางของแหล่งกำเนิดพลาสม่า

เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย (arc power supply) พลาสมາอันประกอบด้วยไอออน บวกและอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกจากผิวน้ำของแคโทดวิ่งไปภายในฟิลเตอร์หรือชุดคลาดฟิลเตอร์ เก้าสิบองศา มีรัศมีความกว้าง 10 เซนติเมตร ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชุดคลาดนี้นท่อกับครึ่งเท่าของระยะเสาธาร นี่คือการต่ออุปกรณ์ดังรูป 2.7 ซึ่งเป็นวงจรขนาดแบ่งกระแสไฟฟ้าผ่านชุดคลาดและลง ground ในปริมาณเท่ากัน

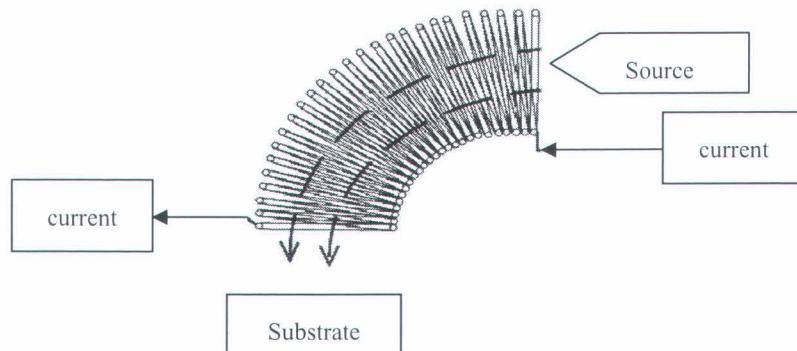


รูปที่ 2.7 วงจรไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

ดังนั้นกระแสไฟฟ้าผ่านชุดคลาดฟิลเตอร์มีค่าประมาณ 250 A เมนี่ยนนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเบี่ยงเบนลำพลาสม่าให้วิ่งไปตอกบนแท่นรับหรือชิ้นงาน (substrate) เมื่อทำการคำนวณขนาดของสนามแม่เหล็ก โดยใช้กฎของแอมแปร์ $B \sim \frac{\mu_0 I N}{2\pi}$ (เป็นการคำนวณโดยประมาณ ค่าที่ได้จริงจะน้อยกว่าค่าคำนวณ) เมื่อแทนค่า $I \sim 250 A$, $N = 12$ ได้สนามแม่เหล็กภายในชุดคลาด $B = 7.5 \times 10^{-4} T$

หน้าที่ของฟิลเตอร์คือเป็นทางผ่านให้ออนุภาคที่มีประจุวิ่งไปตามเส้นแรงแม่เหล็กของสนามแม่เหล็ก เมื่อให้กระแสสู่ฟิลเตอร์ตามลูกศรในรูป 2.8 ภายในชุดคลาดจะเกิดสนามแม่เหล็กในทิศตามเส้นโถง เมื่ออนุภาคหลุดออกจากแหล่งกำเนิดหรือ Source เป้าสู่ฟิลเตอร์จะได้รับแรงกระทำเท่ากับ $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ ทำให้ออนุภาคเคลื่อนที่วนแบบ helix เมื่อพิจารณาของ helix แรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ $\vec{F}_c = \frac{mv^2}{r}$ ซึ่งยิ่งอนุภาคมีขนาดใหญ่หรือมวลมากก็ทำให้หลุดออกนอกวงโค้งของสนามแม่เหล็กจะเดินทางออกฟิลเตอร์ รวมทั้งอนุภาคที่มีประจุรวมเป็นกลาง จะไม่

สามารถวิ่งไปตามเส้นโค้งของฟิลเตอร์ได้ เช่น กัน ดังนั้นจะได้ “ไอน้ำขนาดเล็ก” (micro particle) ตกสะสมบนแท่นรับซึ่งมีการให้กระแสตอบไว้ จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงศักย์สูงแบบต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดไอน้ำขนาดใหญ่เข้ามาเคลือบฝัง



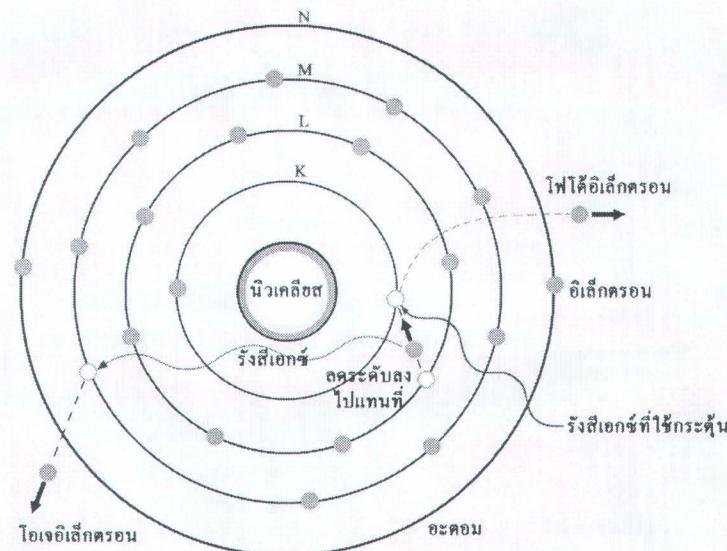
รูป 2.8 ฟิลเตอร์กรองอนุภาคขนาดใหญ่ (Macroparticle filter)

2.5 เครื่องวิเคราะห์ผิวสัมผัส (X – ray Photoelectron Spectroscopy: XPS) [15]

XPS เป็นตัวชี้ของคำเตือนว่า X – ray Photoelectron Spectroscopy ที่อาจแปลเป็นไทยได้ว่า “スペクトロスコピของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์” ดังแสดงในรูปที่ 2.9 อิเล็กตรอนที่ได้รับอิสระภาพด้วยวิธีการแบบนี้เรียกว่า โฟโตอิเล็กตรอน ไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น จะเป็นแสงธรรมชาติ รังสี UV หรือรังสีเอกซ์ก็ตาม

XPS เป็นเทคนิควิเคราะห์ที่ใช้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่สามารถให้ข้อมูลสมบัติทางเคมีที่ระดับพิเศษของวัสดุในหลายเม็ดมุม เช่น ชนิดและจำนวนชาตุองค์ประกอบ โครงสร้างทางเคมี ชนิดพันธะทางเคมี และสถานะของซิเดชันของอะตอม เป็นต้น นอกจากนั้นยังรวมถึงความสม่ำเสมอของชาตุองค์ประกอบ สภาพทางเคมีของผิวที่เปลี่ยนไปหลังถูกกระทบด้วยความร้อน สารเคมี ลำไอ่อน พลาสติก หรือรังสี UV เป็นต้น

เทคนิค XPS ใช้วิเคราะห์วัสดุได้มากน้ำยหลากหลายชนิด ทั้งสาระประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ โลหะพลาสติก อะคริลิค แก้ว เซรามิกส์ สี สารเคลือบ กระดาษ หนัง ไม้ เครื่องสำอาง ฟัน กระดูก ฯลฯ จึงมีอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้องอาศัยเครื่อง XPS เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ แบตเตอรี่ สารเคมี คอมพิวเตอร์ เครื่องสำอาง ในโทรศัพท์มือถือ อาหาร แก้ว ภาชนะ มีน้ำมันหล่อลื่น หลอดไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ กระดาษและไม้ พอลิเมอร์และพลาสติก สิ่งพิมพ์ โลหะ ฯลฯ



รูปที่ 2.9 แผนภาพแสดงปรากฏการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอะตอมที่ถูกกระตุ้นด้วยรังสีเอกซ์ [15]

2.5.1 หลักการทำงานโดยสังเขป

แผนภาพสรุปการทำงานหลักๆ ของเครื่อง XPS แสดงดังรูปที่ 2.9 จุดเริ่มต้นคือ การยิงรังสีเอกซ์พลังงานเดี่ยวใส่รัศมุนีที่ต้องการวิเคราะห์ รังสีเอกซ์นี้จะทราบค่าพลังงานอย่างแน่นอน เพราะผลิตจากหลอดที่เป็นแอลูมิเนียมจะให้รังสีเอกซ์ที่มีพลังงาน 1486.6 eV แต่ถ้าเป็นแมกนีเซียมจะให้พลังงาน 1253.6 eV รังสีเอกซ์ก็ถูกน้ำจัดอยู่ในพวกรีกว่า soft X – rays (ไฟตอนมีพลังงานในย่าน 200 – 2000 eV) รังสีเอกซ์ที่ใช้ถ่ายภาพปอดตามโรงพยาบาลเป็นพวกรีกว่า hard X – rays ที่มีพลังงานในเรือน 10,000 eV ผลิตจากหลอดที่เป็นแอลูมิโนดทำด้วยโลหะหนักจำพวกหงส์เตนและไม่ได้ให้รังสีเอกซ์พลังงานเดี่ยว

รังสีเอกซ์ปลดปล่อยให้อิเล็กตรอนในอะตอมหลุดเป็นอิสระ เรียกว่า ไฟโตอิเล็กตรอน ดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีพลังงานจนเป็นไปตามสมการเบื้องต้นดังนี้

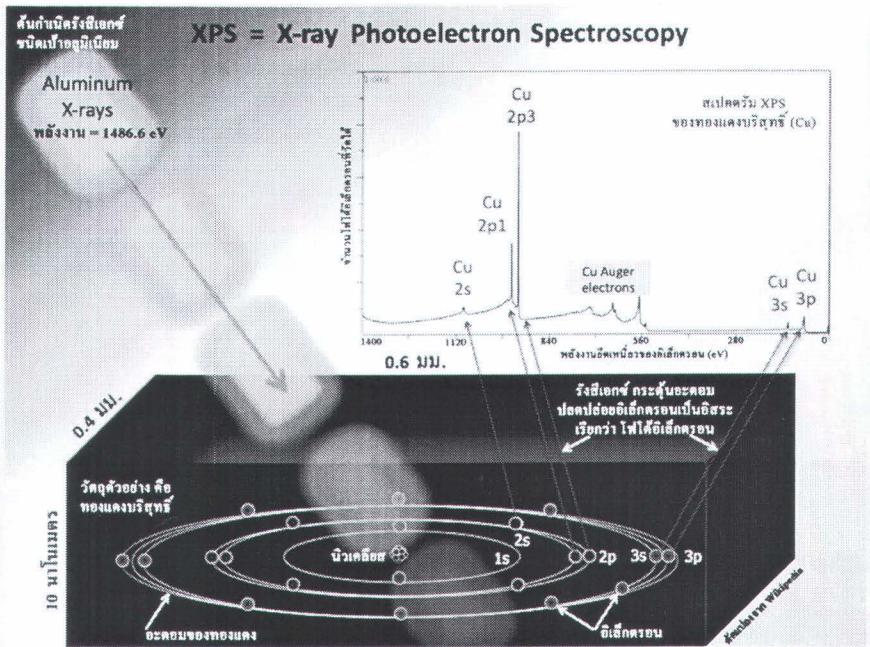
$$\text{พลังงานจนของไฟโตอิเล็กตรอน} \cong \text{พลังงานของรังสีเอกซ์} - \text{พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนในอะตอม} \quad (5)$$

ไฟโตอิเล็กตรอนจากผิวสัมผัสจะถูกรวบรวมและไฟฟ้าไปที่รูปเปิดเล็กๆ ตรงปากทางเข้าของระบบวิเคราะห์ พลังงานของอนุภาคอิเล็กตรอน ด้วยระบบเลนส์ไฟฟ้า ความยาวของชุดเลนส์นี้คือ ประมาณ 50 เซนติเมตร ระบบวิเคราะห์พลังงานของอิเล็กตรอน ประกอบด้วยแผ่นโลหะ

คุณภาพรูปคริสตัลของกัมมันต์ที่บังคับให้อิเล็กตรอนวิ่งโถงด้วยรัศมีเฉลี่ย 16.5 เซนติเมตร จนถึงแพหัววัด วิธีการวัดพลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนแบบนี้ มีขั้นตอนการจำแนกพลังงานสูงมาก คือ มีค่าระหว่าง 0.25 – 0.5 eV เท่านั้น จากพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนที่วัดได้ จากพลังงานของรังสีเอกซ์ที่ทราบค่าແண່อนและจากสมการที่ (5) ทำให้ทราบว่าโฟโตอิเล็กตรอนตัวนี้เคลื่อนย้ายในอะตอมที่ระดับพลังงานใด จากนั้นนำไปสู่การทราบว่าอะตอมนี้คืออะตอมของธาตุอะไร รวมถึงข้อมูลอื่นๆ โดยใช้ Software และ Data base ของเก็บทุกธาตุที่มีผู้ทำไว้แล้วช่วยในการวิเคราะห์ ฐานข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเป็นของ National Institute of Standards and Technology (NIST) ของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ดูที่ <http://srdata.nist.gov/xps/>) ที่กล่าวมาในรูปที่ 2.10

รูปที่ 2.11 เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์พิวของทองแดงบริสุทธิ์ ตำแหน่งของพีค (peak) ต่างๆ ในスペกตรัม XPS เกิดมาจากการท่อนุภาคอิเล็กตรอนทั้ง 29 ตัว จัดเรียงตัวในแต่ละอะตอมของทองแดง ดังนี้ $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(3d)^{10}(4s)^1$ โดยมีค่าของพลังงานยึดเหนี่ยวที่นักฟิสิกส์ได้หาไว้ให้เป็นคังข้อมูลก่อนหน้านี้แล้ว ดังนี้

สัญลักษณ์ของแต่ละวงโคจร (เฉพาะวงในๆ)		พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน ในวงโคจร(eV)
ระดับ K	$1s_{1/2}$	8981
ระดับ L	$2s_{1/2}$	1099
	$2p_{1/2}$	953
	$2p_{3/2}$	933
ระดับ M	$3s_{1/2}$	122
	$3p_{1/2}$	77
	$3p_{3/2}$	75

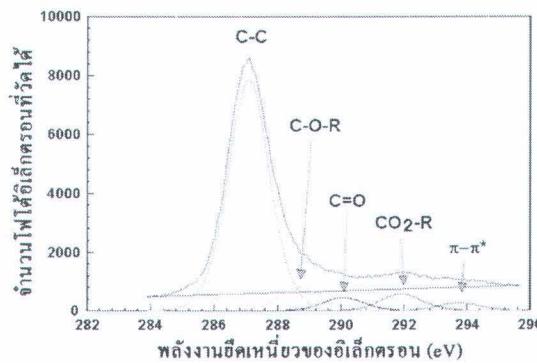


รูปที่ 2.10 แผนภาพสรุปการทำงานหลักๆ ของเครื่อง XPS (2) [15]

ในรูปที่ 2.10 จะเห็นว่ามีพีคของ Auger electron (โอลีกต์رون) ประปนอยู่ด้วย โอลีกต์رونจะเกิดขึ้นจากอะตอม เช่นเดียวกับโฟโตอิเล็กต์رون แต่ที่แตกต่างกัน ก็คือ กลไกของการถือกำเนิด ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 2.9 ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Auger effect เพื่อเป็นเกียรติแก่นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Pierre Auger ที่ค้นพบปรากฏการณ์นี้ในปี 1923 (แต่อนันท์จริงนั้น Lise Meitner นักฟิสิกส์หญิงเชื้อสายยิว ชาวออสเตรียนพบก่อน ในปี 1922) ต่อมาปรากฏการณ์นี้ได้รับการพัฒนาไปเป็นเทคนิควิเคราะห์ผิวสําลุ่ม เช่นเดียวกับ Auger Electron Spectroscopy (AES) เทคนิค XPS และ AES มีความคล้ายคลึงกันมาก ในปัจจุบันจึงสามารถหาได้ในเครื่องเดียวกัน โดยเพียงแต่เพิ่มอุปกรณ์เฉพาะอีกบางอย่าง เช่น เทคนิค XPS ใช้รังสีเอกซ์เป็นตัวกระตุ้นตั้งกล่าวแล้ว แต่เทคนิค AES ใช้รังสีอิเล็กต์رونเป็นตัวกระตุ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่ออะตอมหนึ่งไปมีพันธะกับอะตอมแบบปลอมชนิดอื่น ตำแหน่งและลักษณะของพีคในสเปกตรัม XPS จะเปลี่ยนไปจากเดิม อาจกล่าวได้ว่า เพราะสภาวะแวดล้อมของอะตอมดังกล่าวเปลี่ยนไป เมื่อวิเคราะห์ตั้งนี้ให้ละเอียดทำให้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุล หรือชนิดพันธะทางเคมีใหม่ได้ดังเช่น ตัวอย่างในรูปที่ 2.11 ซึ่งเป็นสเปกตรัม XPS ของโพลีสไตรีน $[C_8H_8]_n$ ที่ถูกอ่อน化ด้วยพลาสม่าของก๊าซออกซิเจน โพลีสไตรีนก่อนอ่อน化พลาสม่าดังกล่าวนั้น จะประกอบไปด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮdroเจนเพียงสองชนิดเท่านั้น แต่หลังจากการอ่อน化ด้วยพลาสม่าออกซิเจนพบว่าสารประกอบดังกล่าวมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไป โดยสามารถ

พิจารณาได้จากพีค C1s ซึ่งพบว่ามีลักษณะเปลี่ยนไป เนื่องจากมีพันธะเคมีระหว่างคาร์บอนกับอะตอมอื่นๆ เกิดขึ้นหลายแบบดังแสดงในรูป



รูปที่ 2.11 ตัวอย่างการวิเคราะห์スペกตรัม XPS ของโพลีส్టีเร็น $[C_8H_8]_n$ [15]

2.6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) [16]

การศึกษาสิ่งซึ่งมีขนาดเล็กๆ หรือที่เรียกว่า จุลทรรศน์ (Microscopy) นั้น นับว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในวิทยาการหลายสาขาในปัจจุบัน เราอาจขยายภาพวัตถุในระดับ 10 เท่าโดยใช้แวงขยายระดับ 10 – 1,000 เท่า โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (OM, Optical Microscope) และระดับ 10 – 1,000,000 เท่า โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (EM, Electron Microscope)

2.6.1 ข้อแตกต่างระหว่าง OM และ SEM

กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (OM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ต่างเป็นเครื่องมือที่งานด้านวิทยาศาสตร์แบบทุกสาขาจะเป็นต้องมีไว้ใช้งาน แต่ถึงแม้ว่าเครื่องมือทั้งสองจะใช้เพื่อการขยายภาพวัตถุต่างๆ เช่นเดียวกัน แต่หลักการทำงานต่างกันอย่างมาก

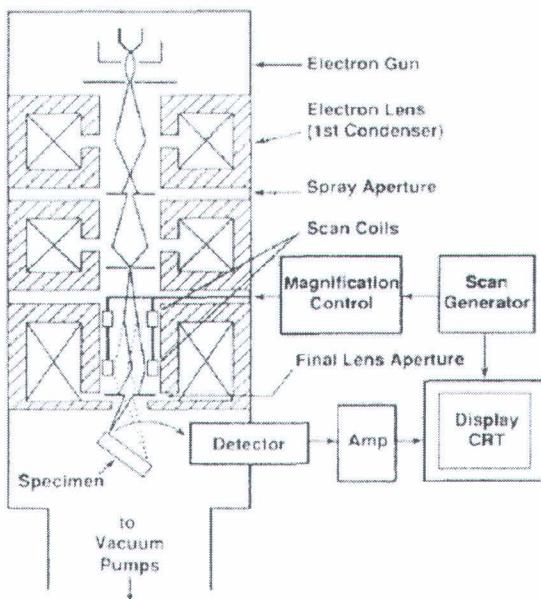
OM นั้นเป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานมากกว่า เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถศึกษาวัตถุ หรือตัวอย่างในบรรยายศักดิ์หรือในของเหลว เช่น น้ำ หรือน้ำมัน ได้ ภาพขยายของตัวอย่างที่ได้ จะให้สีจริงตามธรรมชาติและสามารถขยายภาพของตัวอย่างได้ตั้งแต่ 10 – 1,000 เท่า ซึ่งปัจจุบันสามารถดูภาพผ่านจอทีวีหรือคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้พิมพ์ภาพ หรือเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผล เช่น การวัดขนาดอนุภาค ได้สะดวกขึ้น แต่ OM ก็มีข้อจำกัดที่ ความชัดลึก (depth of field) ของภาพขยาย ยิ่งกำลังขยายมากขึ้น ระยะชัดลึกยิ่งน้อยลง

SEM มีจุดเด่น คือมีระบบชัดลึกมากกว่า และมีอำนาจแยกแบ่งเชิงระยะ (Spatial resolution) สูงกว่า OM ทั้งนี้ เพราะอุปกรณ์ทั้งสองใช้แหล่งกำเนิดคลื่นซึ่งมีความยาวคลื่นต่างกัน เป็นตัวสร้างภาพ OM ใช้คลื่นแสง (แสงที่ตามนุษย์มองเห็น) ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 400 –

700 นาโนเมตร ทำให้ OM ไม่สามารถขยายวัตถุที่เล็กกว่า 0.2 ไมครอน ได้ ส่วน SEM จะใช้คุณสมบัติคลื่นของอิเล็กตรอน ซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นกว่า ทำให้ SEM มีอำนาจแยกและเชิงระยะ ได้มากถึง 0.2 นาโนเมตร และด้วยความสามารถในการบีบคำอิเล็กตรอนให้เป็นมุมแคบๆ ได้ ทำให้ได้ภาพที่มีความชัดลึกสูง นอกจากนี้ SEM ยังสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น เช่น Energy Dispersive Spectrometry (EDS) และ Wavelength Dispersive Spectrometry (WDS) เพื่อให้มีข้อมูลด้านองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง ได้อีกด้วย

2.6.2 การทำงานของ SEM

ส่วนประกอบและหลักการทำงานโดยสังเขปของ SEM แสดงในรูปที่ 2.9 ส่วนบนสุด เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนที่เรียกว่า ปืนอิเล็กตรอน (electron gun) อิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดจะถูกเร่งให้เคลื่อนที่ตามความคอลัมน์ซึ่งมีสภาพสุญญากาศ ด้วยความต่างศักย์เร่ง (Accelerating Voltage) ในช่วง 0 – 30 kV (บางเครื่องอาจทำได้สูงถึง 50 kV) โดยทิศทางการเคลื่อนที่จะถูกควบคุมด้วยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic lens) 2 ชุด หรือมากกว่า และปริมาณของอิเล็กตรอนจะถูกควบคุมโดยแอปเพอร์เชอร์ (aperture) หรือช่องเปิด ซึ่งมีขนาดต่างๆ กัน ตามลักษณะการใช้งาน



รูปที่ 2.12 ส่วนประกอบและหลักการทำงานของ SEM [16]

เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าชุดแรกที่เรียกว่า เลนส์คอนเดนเซอร์ (Condenser lens) นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่สุดต่อการควบคุมทัศนศาสตร์อิเล็กตรอน (electron optics) เพราะเป็นเลนส์ที่ทำหน้าที่บีบอิเล็กตรอนที่วิ่งลงมาจากแหล่งกำเนิดให้เป็นลำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กลง

ส่วนเลนส์วัตถุ (Objective lens) ซึ่งเป็นเลนส์ชุดสุดท้าย จะทำหน้าที่โฟกัสลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้ไปตกบนผิวของตัวอย่าง โดยมีสแกนคoil (scan coil) ทำหน้าที่ราดลำอิเล็กตรอนให้ไปบนผิวของตัวอย่างภายในกรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งพื้นที่ผิวของตัวอย่างบริเวณที่ถูกยิงด้วยลำอิเล็กตรอนนี้ จะเกิดสัญญาณ (signal) ต่างๆ ขึ้นหลายชนิดในเวลาเดียวกัน และ SEM จะมีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับสัญญาณ (Detector) ชนิดต่างๆ เหล่านี้ แล้วส่งไปประมวลผลเป็นภาพ แสดงบนจอภาพคือไป ตัวอย่างสัญญาณที่เกิดขึ้นนั้นได้แก่

อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electrons, SE) สัญญาณชนิดนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เป็นสัญญาณที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างภาพมากที่สุด ภาพที่ได้จากสัญญาณชนิดนี้เรียกว่า ภาพอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electrons Image, SEI)

อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Back Scattered Electrons, BSE) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีบนผิวของตัวอย่าง และแสดงให้เห็นลักษณะความสูงต่ำของพื้นผิว

นอกเหนือจากสัญญาณเหล่านี้แล้วยังมีสัญญาณอีกหลายชนิดที่เกิดขึ้น เช่น เอ็กซเรย์ (X-Ray), คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave), อะเจอิเล็กตรอน (Auger electron) เป็นต้น ซึ่งสัญญาณแต่ละชนิดจะให้ข้อมูลของตัวอย่างแตกต่างกันไป

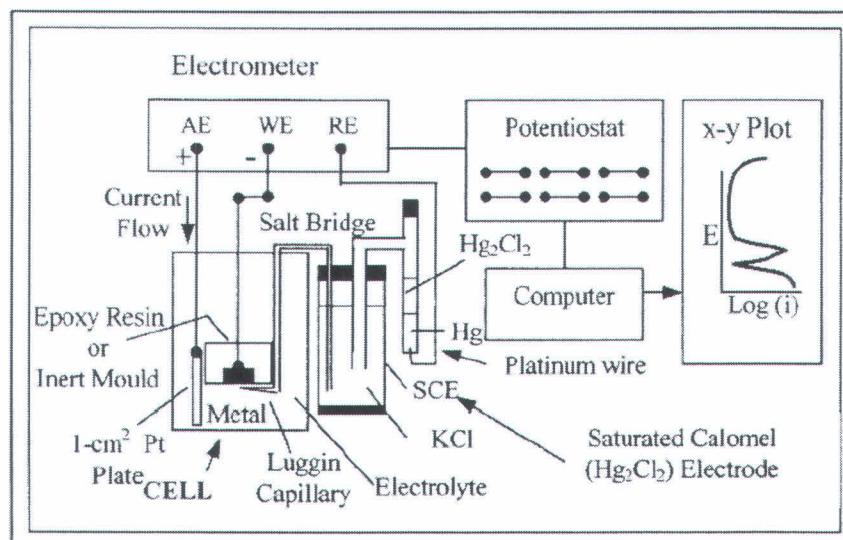
2.7 การทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Test) [17]

พฤติกรรมการกัดกร่อนทางอิเล็กโทรเคมีของโลหะและอัลลอยบ่องบกถึงลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดพื้นผิวที่แตกต่างกัน ซึ่งศึกษาได้จากลักษณะของกราฟโพลาไรเซชัน ธรรมชาติของวัสดุประเภทโลหะจะค่อนข้างถูกกัดกร่อนในสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนอิเล็กโทรไลท์เข้มข้นสำหรับโลหะ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกไซเดชันได้ง่ายและสร้างสิ่งที่เรียกว่าพาสซิฟ หรือออกไซซ์ฟิล์มเพื่อป้องกันตัวเองจากการกัดกร่อน อย่างไรก็ตามในการทดสอบพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะจะเพิ่มศักย์ให้กับโลหะและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าจะแปรผันตามค่าศักย์ฟิล์มออกไซด์ของโลหะเหล่านี้จะถูกกัดกร่อนจนกระทั่งหลุดร่องเนื้อโลหะดังเดิม หรือเรียกว่าเกิดการ “เบรกดาวน์” จากนั้นอัตราการกัดกร่อนจะเพิ่มขึ้น เริ่มกราฟที่บันทึกระหว่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าว่า กราฟโพลาไรเซชัน

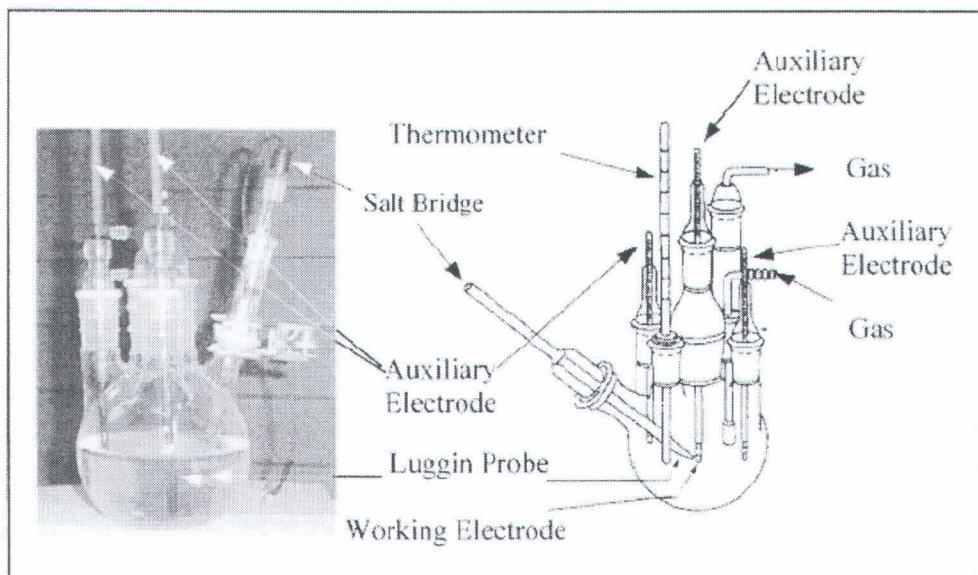
2.7.1 เครื่องมือในการทดสอบ (Instrumentation)

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อนทางอิเล็กโทรเคมี ออกแบบอุปกรณ์ดังรูป 2.13 พาวเวอร์ซัฟเฟลัยซึ่งเรียกว่า potentiostat ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมศักย์ไฟฟ้า และ galvanostat ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า การออกแบบนี้ให้ผลที่น่าพอใจเหมาะสมสำหรับชี้นงานที่มีลักษณะแบบบาง เครื่องมือประกอบด้วยอิเล็กโทรดสามชนิดได้แก่ อิเล็กโทรดแรก

working electrode (WE) WE ชิ้นงานจะถูกยึดกับลวดนำไฟฟ้าที่เคลือบด้วยเรซินซึ่งจะไม่กัดกร่อนในสารละลายที่ต้องการใช้ทดสอบ รูปที่ 2.14 เป็นเครื่องมือ ASTM G-5 Standard electrochemical cell ออกแบบโดย EG&G Princeton Applied Research รุ่น Model K47 เซลล์นี้ประกอบด้วย auxiliary graphite อิเล็กโทรดอีกสองชนิดที่จะใช้ตรวจสอบลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่เกิดบริเวณผิวน้ำชิ้นงาน เซลล์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ เซลล์แบบสามอิเล็กโทรด (Three-electrode cell)



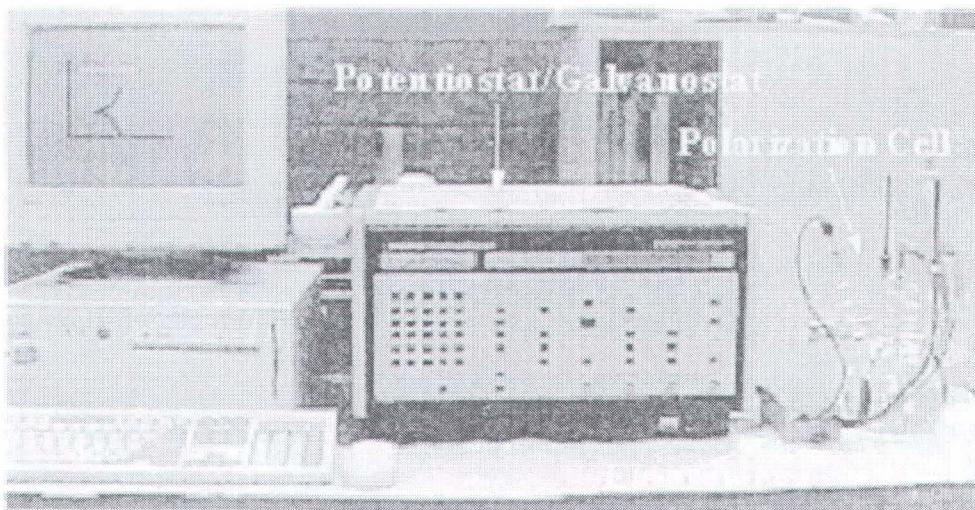
รูปที่ 2.13 แผนภาพอุปกรณ์ในการหาโพลาไรเซชัน [17]



รูปที่ 2.14 เซลล์อิเล็กโทรเคมี [17]

การศึกษาการกัดกร่อนจะดูจากศักย์กัดกร่อน (corrosion potential) กระแสไฟฟ้ากัดกร่อน (corrosion current) ความต้านทานโพลาไรซ์ (linear polarization resistance) ทาเฟลเพล็อต (tafel plot) โพเทนติโอลามิก โพลาไรซ์เซชัน (potentiodynamics polarization) อัตราสแกน (scan rate) และ ไซคลิก โพลาไรซ์เซชัน (cyclic polarization) เทคนิคปกติที่ใช้สำหรับทดสอบทางอิเล็กโทรเคมี ได้แก่ เทคนิค potentiostatic, potentiodynamics, galvanostatics และ galvanodynamics โดยมากแล้ว จะติดตั้งเครื่องมือเป็น potentiostat เมื่อจ่ายค่าศักย์ไฟฟ้าและวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ตอบสนอง หรือ เป็น galvanostat เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า แล้ววัดค่าศักย์ไฟฟ้าที่ตอบสนอง เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมในการศึกษาพื้นผิวที่ถูกเคลือบด้วยออกไซด์และในไตรด์ระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า

เครื่องมือติดตั้งตามรูปที่ 2.15 ในการทดลองนี้เป็นเครื่อง 273A potentiostat/galvanostat แผนภาพวงจรไฟฟ้าสำหรับโพเทนติโอลัตเต็มพื้นฐานหาได้ทั่วไป หน้าที่หลักของโพเทนติโอลัตเต็มคือควบคุมความต่างศักย์ไฟฟาระหว่าง working electrode (WE) และ reference electrode (RE) โดยการจ่ายกระแสผ่านทาง counter electrode (CE)



รูปที่ 2.15 ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องมือสำหรับทดลองไฟฟ้าไซคลิก [17]

2.7.2 ระบบสามอิเล็กโทรด (Three – electrode system)

แผนภาพในรูป 2.11 ความต่างศักย์ไฟฟ้าในชิ้นงานจะถูกวัดเทียบระหว่าง RE กับ WE กระแสจะจ่ายกระแสให้ไหลระหว่าง CE กับ WE

- แพลตตินัม เคานเตอร์อิเล็กโทรด เป็นตัวให้กระแสไฟ流ผ่านไปสู่ WE เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

- ลักษณะ แคปิลารี เป็นหัววัดหรือหลอดเล็กๆที่ภายในบรรจุสารอิเล็กโทร ไอลท์ ในที่นี้ใช้ KCl ลักษณะและสภาพเกลือเชื่อมต่อกับเซลล์ของ RE การต่อแบบแยกนี้ทำให้ความด้านท่านระหว่าง WE และ AE ลดลง

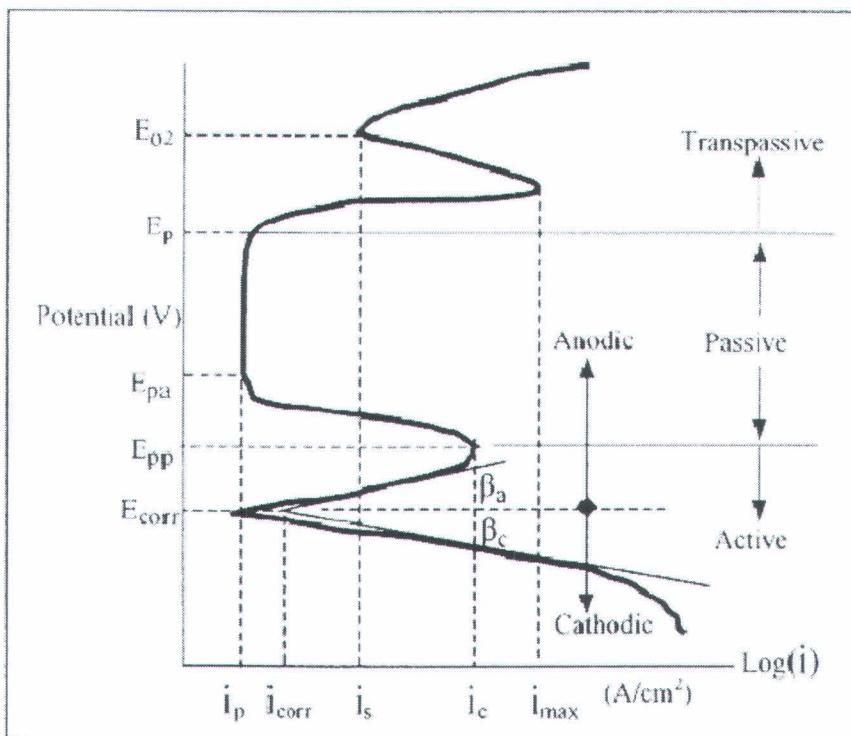
● WE เป็นอิเล็กโทรดที่เชื่อมต่อกับชิ้นงาน ซึ่งจะต้องมีพื้นที่ที่ใช้ทำปฏิกิริยาเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่ง แนะนำพื้นที่ 1 cm^2 ระยะระหว่าง WE พื้นที่ผิวและปลายเข็มของหัววัดลักษณะห่างกันในช่วง $1\text{mm} < x < 2\text{mm}$ เรซินที่เคลือบกับสายโลหะซึ่งอยู่จาก WE ไม่ควรเป็นสารที่เกิดปฏิกิริยา กัดกร่อน เพราะจะทำให้ค่าแก่เวลาที่ใช้ในการทดสอบความคงทนให้คงที่

● Potentiostat เป็นเครื่องมือที่สำหรับวัดค่าศักย์ไฟฟ้า ความหนาแน่นกระแส และพลังงาน เป็นกราฟระหว่าง E กับ $\log I$ ได้ ควรใช้ร่วมกับมิเตอร์ไฟฟ้า ตัวแปลงค่าเป็นกระแสสัมภาระที่มีตัวเก็บข้อมูล และควรเป็นเครื่องมือที่สามารถจ่ายศักย์ไฟฟ้าที่ต่อเนื่องต่อช่วงเวลา หรือเรียกว่ามี scan rate ที่คงที่ในช่วงของศักย์ไฟฟ้าที่ผู้ทดลองต้องการ ยกตัวอย่าง ต้องการทดลองในออเดอร์ $-2\text{V} < x < 2\text{V}$ ได้กราฟโพลาไรซ์ที่มีทั้งค่าของแอนодิกและแครอติกในกราฟด้วย วิธีการดังกล่าวนั้นเรียกว่า เทคนิค potentiodynamic polarization ทั้งนี้ตัวแปรของเวลาที่ใช้ในการรันทั้งช่วง steady-state และช่วงเกิดปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้ามีความสำคัญควรกำหนดให้เท่าๆ กัน

จากรูป 2.16 แสดงกราฟโพลาไรซ์ของชิ้นงานอุดมคติ (ideal) และตัวแปรต่างๆ

2.7.3 กราฟโพลาไรเซชัน (Polarization Curves)

รูปที่ 2.17 แสดงกราฟโพลาไรซ์ที่ระดับศักย์ไฟฟ้าค่าต่างๆ เป็นลำดับตั้งแต่น้อยไปมาก ของ Eutectoid มีพื้นที่ของแครอติกและแอนодิกอย่างชัดเจน และง่ายต่อการเขียน ทางเฟลสโลป (Tafel Slope) ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากสัมผัสกับเส้นโถงแครอติกและเส้นโถงแอนодิก จุดตัดของทั้งสองเส้นจะได้ค่าของศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนหรือ V corrosion: V_{corr} และกระแสไฟฟ้ากัดกร่อน หรือ I corrosion: I_{corr} สังเกตว่า ข้อมูลในกราฟโพลาไรเซชันครอบคลุมค่าของ ศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนซึ่งเท่ากับ -0.51 V_{SCE} แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในรูป 2.17 ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการพลีอตข้อมูล ทั้งกระบวนการ ดังนั้นควรใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นอัตโนมัติซึ่งหมายความว่า สม่ำเสมอของการทดสอบ ชนิดนี้



i_p = Passive current density

E_{pa} = Passive potential

i_{corr} = Corrosion current density

E_{corr} = Corrosion potential

i_s = Secondary current density

E_{o2} = Oxygen evolution potential

i_c = Critical current density

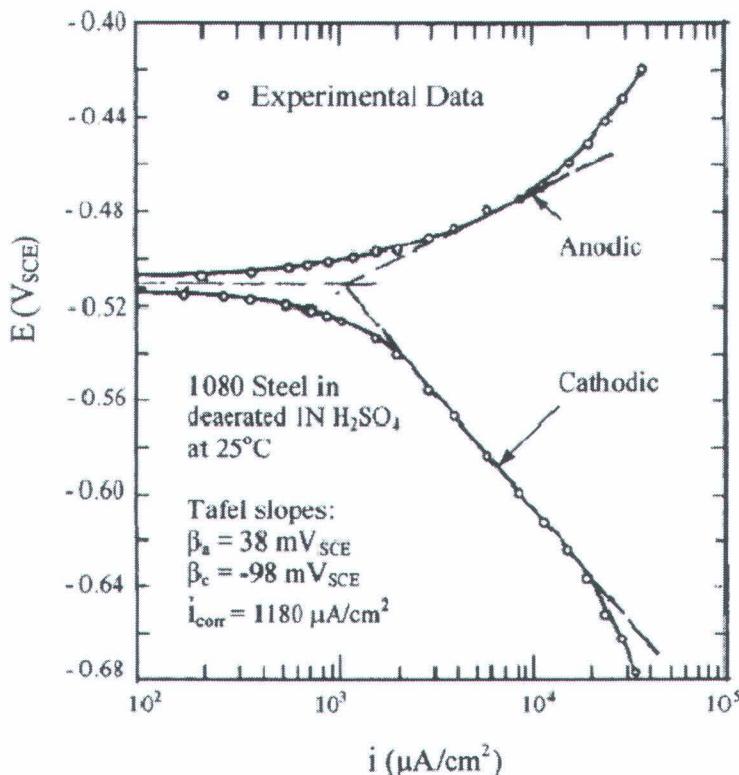
E_{pp} = Primary passive potential

i_{max} = Maximum current density

E_p = Pitting potential

รูปที่ 2.16 กราฟโพราไรเซชันของชิ้นงานอุดมคติ [17]

นอกจากนี้ลักษณะของกราฟโพราไรซ์ยังบอกได้ว่าวัสดุชิ้นที่ใช้ทดสอบมีลักษณะเป็น “แอคทีฟ” หรือ “แพสซีฟ” หรือเป็นได้ทั้ง “แอคทีฟ-แพสซีฟ” ในสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง แตกต่างกันไป วิธีการทดสอบแบบโพเทนดิโอลามิกเป็นวิธีที่เหมาะสม สำหรับการทดสอบห้องส่องลักษณะ แต่วิธีโพเทนดิโอลามิกนั้นจะได้ผลดีขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่า scan rate (mV/s) ด้วย ค่า scan rate ที่ชาหรือค่าน้อยจะทำให้ได้กราฟที่มั่นคง สม่ำเสมอ และได้ค่าศักย์กัดกร่อนที่คงที่ไม่แก่เวลา ทั้งนี้อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะในการทดสอบนั้น ได้แก่ อุณหภูมิ, ความเข้มข้นของสารละลาย, scan rate, การนำพาหรือความร้อนรวมถึงความดันด้วย



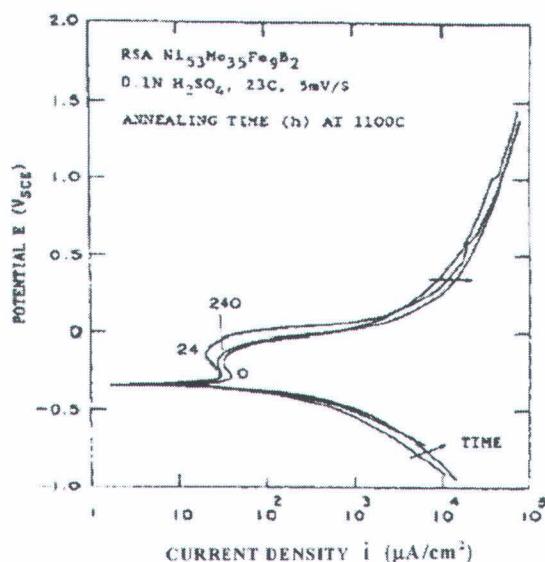
รูปที่ 2.17 กราฟโพราไรเซชันที่ระดับศักยไฟฟ้าค่าต่างๆ ของ 1080 eutectoid steel ในสารละลายกรดซัลฟูริก 1N

2.7.4 ฟิล์มพาสซีฟออกไซด์ (passive oxide film)

กระบวนการแพสซีฟเป็นปฏิกิริยาเคมีที่จะเกิดบนผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับอิเล็กโทรไลท์ ผลที่ได้คือของแข็งบางเป็นฟิล์มที่เป็นสารประกอบของโลหะออกไซด์ กระบวนการนี้เป็นลักษณะ “แอคทีฟ-แพสซีฟ” อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก หรืออาจเกิดจากการกระตุ้นศักยไฟฟ้าจากภายนอกที่ได้เชื่อมกัน ในที่นี่เราจะกล่าวถึงกระบวนการแพสซีฟที่เกิดจากการกระตุ้นจากศักย์ภายนอก ฟิล์มแพสซีฟออกไซด์เป็นของแข็งที่ผิวนานาเพื่อป้องกันโลหะจากกระบวนการกัดกร่อนมีความหนาประมาณ $1 - 10 \text{ nm}$ ซึ่งฟิล์มนี้มีความบางประมาณ $1 - 2 \text{ nm}$ จะมีคุณภาพมากกว่าฟิล์มนานาเนื่องจากมีผลกระทำระหว่างอะตอมต่ออะตอมน้อย แต่ฟิล์มแพสซีฟจะไม่เสื่อมเมื่อยืดในศักย์หรือกระแสที่เข้มหรือลงแตกต่างกันมาก กล่าวคือโลหะจะไม่สามารถรักษาฟิล์มแพสซีฟได้หากถูกรบกวนโดยการทำให้ถูกกัดกร่อนเพิ่มขึ้น ฟิล์มนี้จะเกิดรูและในที่สุดก็จะ “เบรกดานน์” หรือฟิล์มแตก สิ่งรบกวนสามารถทะลุเข้าถึงเนื้อโลหะได้ในที่สุด

นอกจากนี้กระบวนการแพสซีฟทางเคมีเป็นสถานะที่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาเคมีที่กระตุ้น ผิวน้ำของโลหะ ในขณะที่กระบวนการแพสซีฟทางอิเล็กโทรเคมีจะขึ้นอยู่กับศักย์แอลโโนดิก

ภาชนะออกที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาแคโรติก จากรูปที่ 2.13 บริเวณ $i_p - i_c$ บ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากแอคทีฟเป็นแพสซีฟ แทนอค่า E_{pp} แพสซีฟจะเริ่มจาก i_c และหยุดที่ i_p ดังนั้นกระบวนการสร้างฟิล์มจึงเกิดที่บริเวณนี้ ความหนาของฟิล์มจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสักยีท่ากับ E_{pa} ที่ i_p สิ่งที่เป็นตัวควบคุมความหนาคือไอออนนำไฟฟ้าในสารละลาย ถ้าโลหะสร้างไอออนที่นำไฟฟ้าได้มากจะก่อให้เกิดฟิล์มแพสซีฟที่หนาขึ้น ดังนั้นสิ่งที่บ่งบอกความแข็งแรงของแพสซีฟฟิล์มคือความกว้างของช่วง $i_p - i_c$ ความเสถียรของฟิล์มแพสซีฟจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความกว้างของช่วงสักยีที่ $E_{pa} < E < E_p$ ยิ่งมีความกว้างมากก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าโลหะสามารถสร้างฟิล์มแพสซีฟที่เสถียร ในรูป 2.18 แสดงกระบวนการแพสซีฟที่ไม่เสถียร เพราะเมื่อเพิ่มสักยีแก่ชิ้นงานค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงเกิดการกัดกร่อนรุนแรงขึ้นตามไปด้วย



รูปที่ 2.18 กราฟโพราไรเซชันของ RSA Ni – Mo base อัลลอยด์ ในสารละลายกรดซัลฟูริก

โลหะกับอัลลอยด์ส่วนใหญ่จะไม่ให้ผลเป็นอุคณคิตดังเช่นกราฟในรูป 2.17 เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ส่วนผสมของโลหะหรืออัลลอยด์ ซึ่งเป็นโพลีคริสตัลซึ่งเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนส่งผลต่อพฤติกรรมการเกิดกระบวนการแพสซีฟด้วย รวมถึงสารละลายอิเล็กโทร ไลท์ด้วย